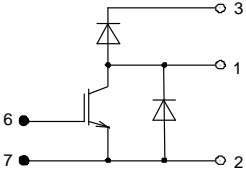
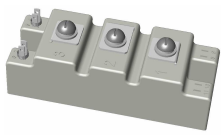




ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**"НПО "ЭНЕРГОМОДУЛЬ"**142190, Московская обл.,  
г. Троицк, Сиреневый бульвар, д. 15  
Тел.: (495) 220-62-83Филиал: 428024, г. Чебоксары, проспект Мира, д. 90/1, тел./факс: (8352) 28-64-77, тел. (8352) 28-63-55, [www.energomodul.ru](http://www.energomodul.ru), e-mail: [energomodul@list.ru](mailto:energomodul@list.ru)**Силовой IGBT модуль на 75А, 1200В**

<b>МДТКИ-75-12</b>	 <p>Схема электрическая принципиальная</p>	 <p>габариты: 94x34x36 мм установочные размеры: 80 мм масса, не более 170 г</p>
--------------------	---	--

**Предельно допустимые значения параметров модуля МДТКИ-75-12**  
T<sub>j</sub>=25 °С, если не указано другое

Наименование параметра, единицы измерения	Обозначение	Условия измерения	75-12	
			не менее	не более
1 Напряжение коллектор-эмиттер, В	<b>V<sub>ce max</sub></b>	V <sub>ge</sub> =0 В,	1200	
2 Максимальный постоянный ток коллектора, А	<b>I<sub>c</sub></b>	V <sub>ge</sub> =15 В, T <sub>c</sub> = 70°С		75
3 Импульсный ток коллектора, А	<b>I<sub>c</sub></b>	V <sub>ge</sub> =15 В, T <sub>c</sub> = 70°С		150
4 Пробивное напряжение изоляции между силовыми выводами и основанием, В	<b>Visol</b>	f=50 Гц, при t=1 мин Эффективное значение	2500	
5 Температура перехода, °С	<b>T<sub>j max</sub></b>	—	-55 ÷ +150	
6 Постоянный прямой ток диода, А	<b>I<sub>F</sub></b>	T <sub>c</sub> =25°С		75
7 Импульсный прямой ток диода, А	<b>I<sub>FM</sub></b>	T <sub>c</sub> =25°С		150

T<sub>c</sub> – температура основания

## Статические параметры модуля МДТКИ-75-12

T<sub>j</sub>=25 °С, если не указано другое

Наименование параметра, единицы измерения	Обозначение	Условия измерения	75-12	
			не менее	не более
1 Напряжение пробоя коллектор-эмиттер, В (допустимый ток утечки коллектора)	V(br)ces	V <sub>ge</sub> =0 В,	1200	1,5
		при I <sub>ce</sub> → мА		
2 Пороговое напряжение затвор-эмиттер, В	V <sub>ge(th)</sub>	V <sub>ge</sub> = V <sub>ce</sub> T <sub>j</sub> = 25 °С T <sub>j</sub> =55 °С	3,0 3,3	6,5 6,8
		при I <sub>ce</sub> → мА	3,0	
3 Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, (типичное), В	V <sub>ce(sat)</sub>	V <sub>ge</sub> =15 В, T <sub>j</sub> = 25 °С T <sub>j</sub> =125 °С	2,2 2,3	2,7 2,8
		при I <sub>c</sub> → А	75	
5 Ток утечки коллектор-эмиттер, мА	I <sub>ces</sub>	V <sub>ge</sub> =0 В, T <sub>j</sub> = 25 °С T <sub>j</sub> =125 °С		2,0 3,2
6 Ток утечки затвор-эмиттер, нА	I <sub>ges</sub>	T <sub>j</sub> =125 °С V <sub>ce</sub> =0 В		±500
5 Тепловое сопротивление чип-корпус, °С/Вт, IGBT	R <sub>th jc</sub>			0,29
7 Ток обратного восстановления, А	I <sub>rrm</sub>	V <sub>cc</sub> =600 В, V <sub>ge</sub> =±15 В L <sub>s</sub> =50 нГ, T <sub>j</sub> =125°С		75
8 Прямое падение напряжения на обратном диоде, (типичное), В	V <sub>F</sub>	V <sub>ge</sub> =0 В, T <sub>p</sub> <80 мкс, D < 2% T <sub>j</sub> = 25 °С	(2,0)	2,3
		I <sub>F</sub> , → А	75	

# Динамические параметры модуля МДТКИ-75-12

T<sub>j</sub>=25 °C, если не указано другое

Наименование параметра, единицы измерения	Обозначение	Условия измерения	75-12		
			типовое	не более	
1 Входная емкость, нФ	<b>Cies</b>	V <sub>ge</sub> =0 В, f =1 МГц V <sub>ce</sub> =25 В	7,5		
2 Выходная емкость, нФ	<b>Coes</b>	V <sub>ge</sub> =0 В, f =1 МГц V <sub>ce</sub> =25 В,	1,6		
3 Проходная емкость, нФ	<b>Cres</b>	V <sub>ge</sub> =0 В, f =1 МГц V <sub>ce</sub> =25 В	1,4		
4 Время задержки включения, нс	<b>td(on)</b>	V <sub>ge</sub> =±15 В, L <sub>n</sub> =0.25 мГн, L <sub>s</sub> =50 нГ, V <sub>cc</sub> =600 В;  при I <sub>c</sub> →, А R <sub>g</sub> →, Ом	100	200	
5 Время нарастания, нс	<b>tr</b>		50	100	
6 Время задержки выключения, нс	<b>td(off)</b>		450	800	
7 Время спада, нс	<b>tf</b>		90	190	
8 Энергия при включении, мДж	<b>Eon</b>			8,5	
9 Энергия при выключении, мДж	<b>Eoff</b>			7,0	
				75	
				15	
10 Полный заряд затвора, нКл	<b>Qg</b>			750	
11 Время восстановления обратного диода, мкс	<b>trr</b>	V <sub>cc</sub> =600 В, V <sub>ge</sub> =±15 В L <sub>s</sub> =50 нГ, T <sub>j</sub> =125 °C при I <sub>F</sub> , → А  R <sub>g</sub> , → Ом	0,12	0,4	
			75		
			2,4		
12 Заряд обратного восстановления, мкКл	<b>Qrr</b>		52		
13 Энергия обратного восстановления, мДж	<b>Erec</b>		27		

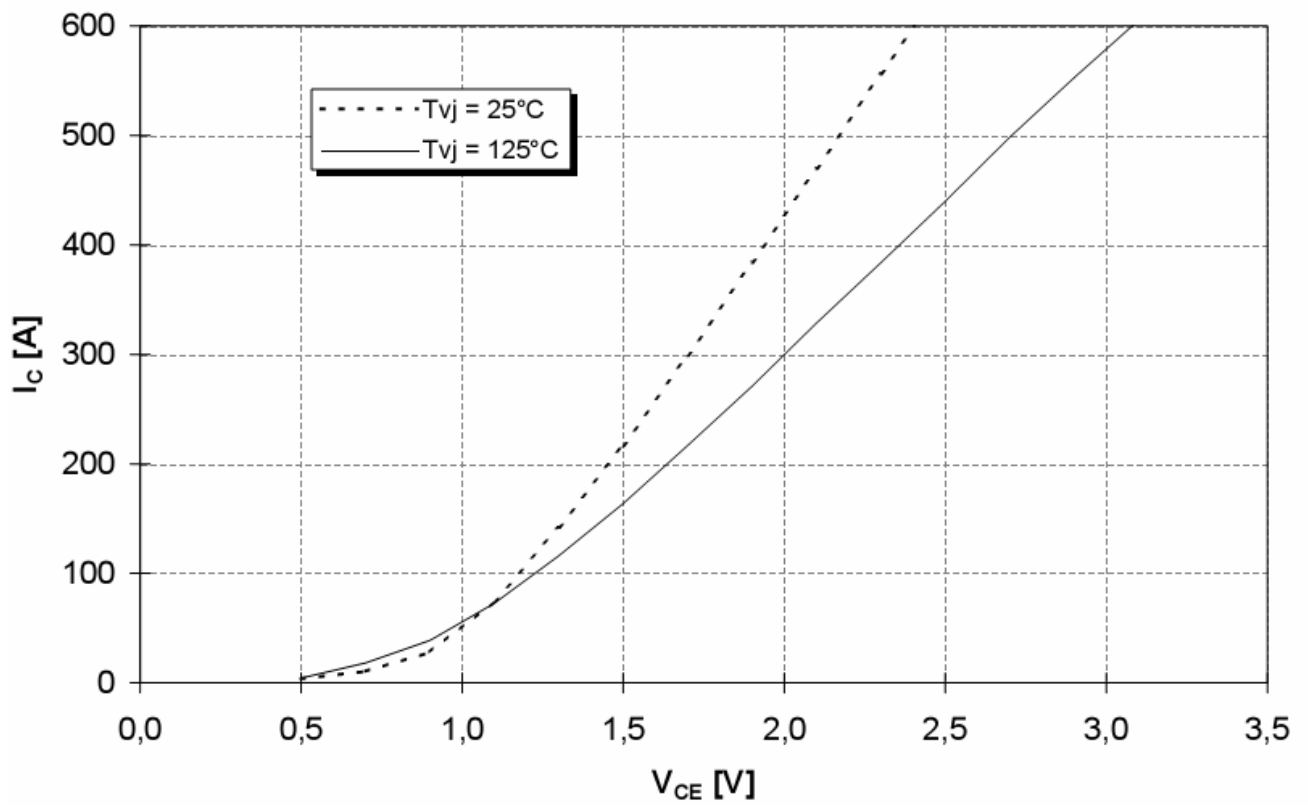


Рис. 5. Зависимость напряжения насыщения от тока коллектора.  
 $I_c = f(V_{ce}), V_{ge} = 15\text{В}$

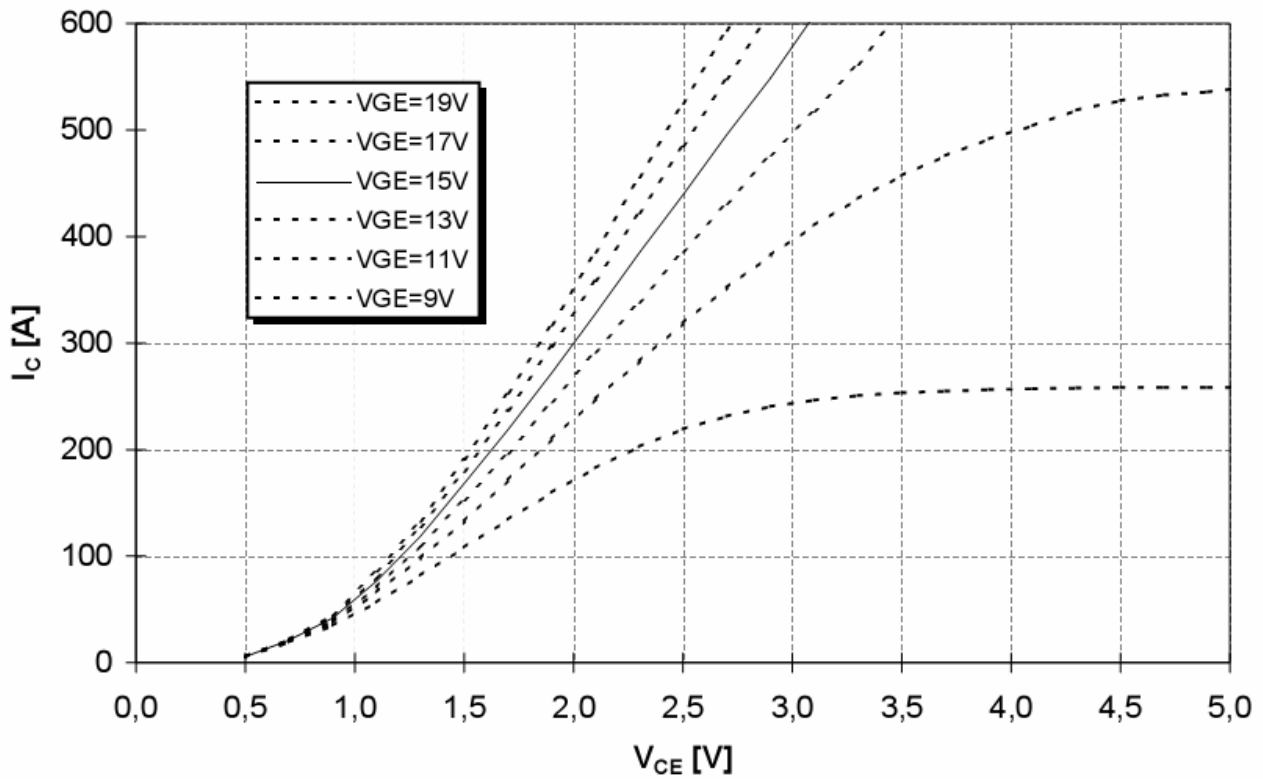


Рис. 6. Зависимость напряжения насыщения от тока коллектора.  
 $I_c = f(V_{ce}), T_j = 150^\circ\text{C}$

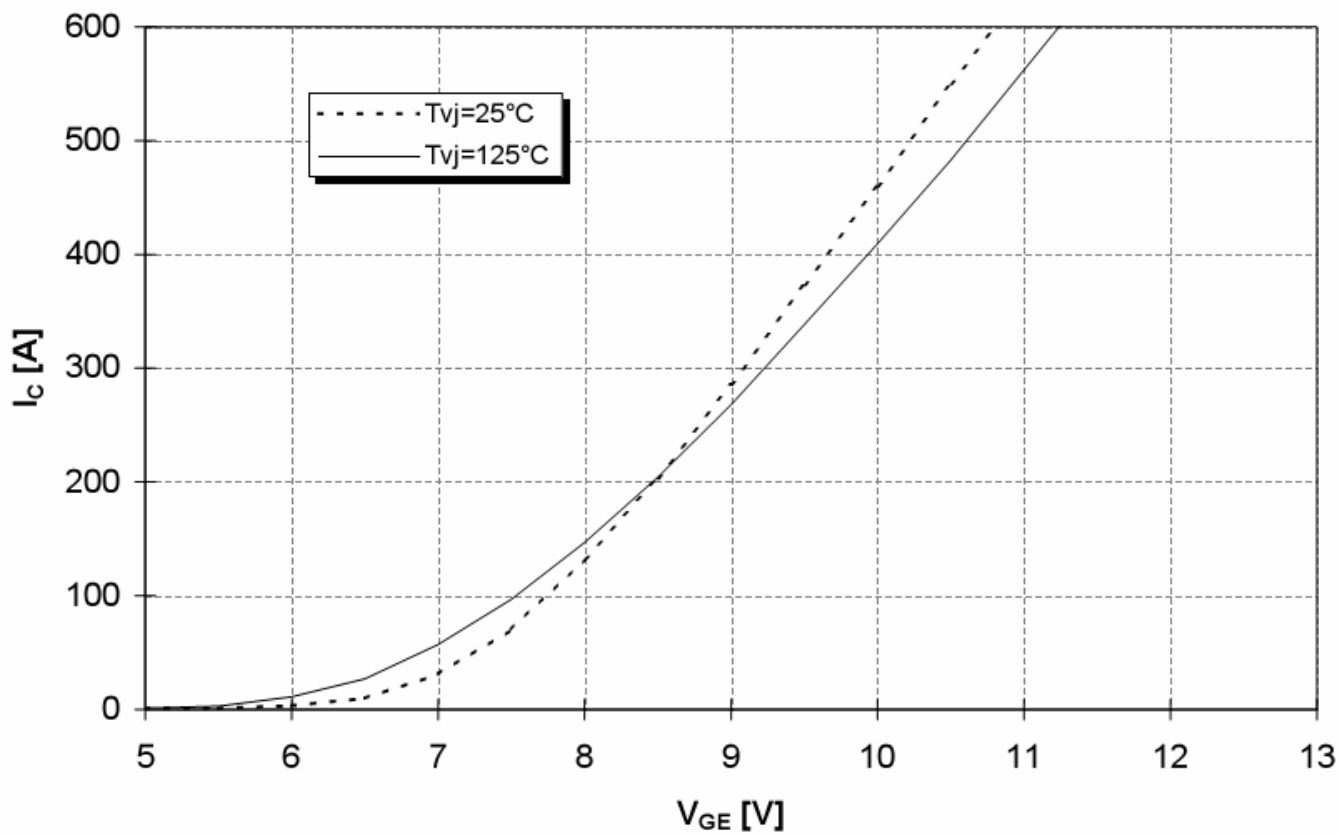


Рис. 7. Зависимость тока коллектора от напряжения затвор-эмиттер.  
 $I_c=f(V_{ge}), V_{ce}=20\text{В}$

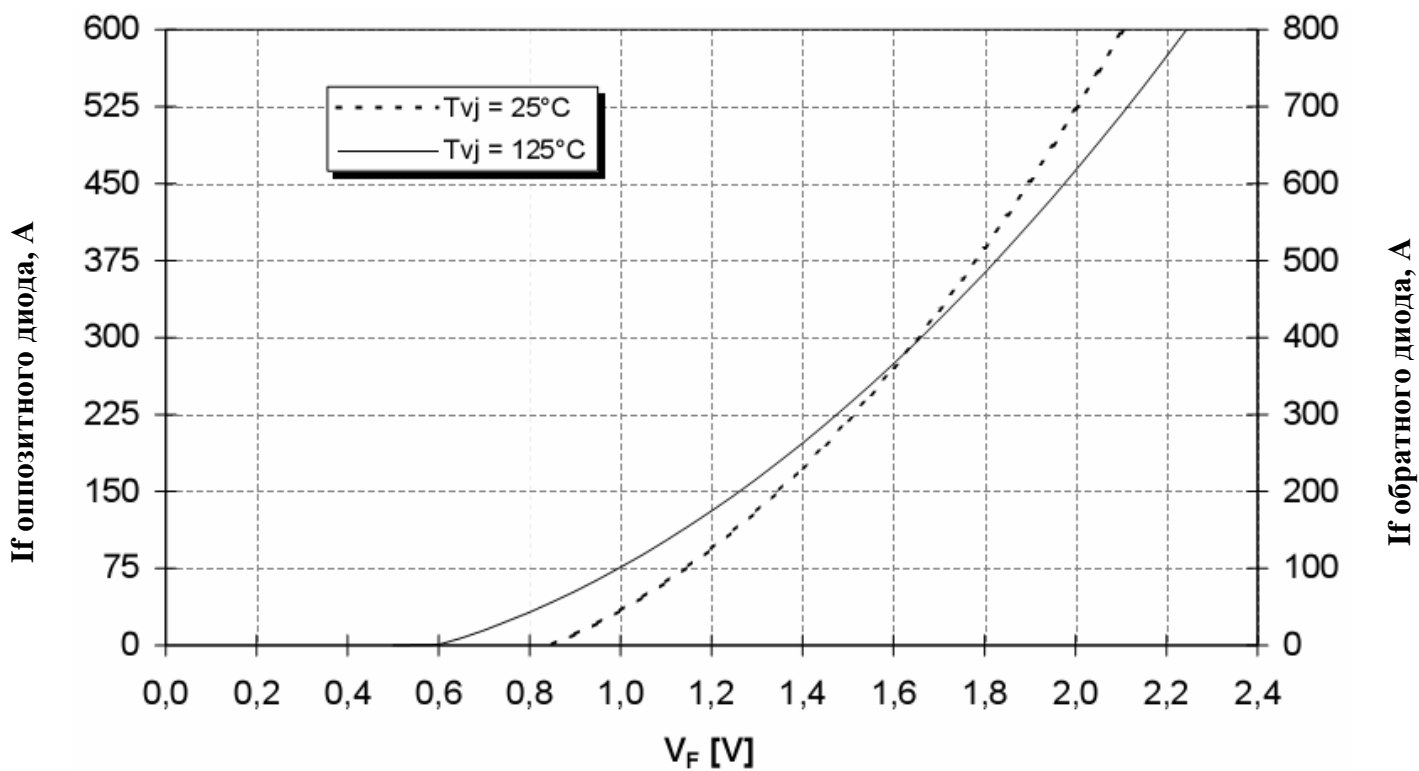


Рис. 8. Зависимость прямого падения напряжения диода от тока диода.

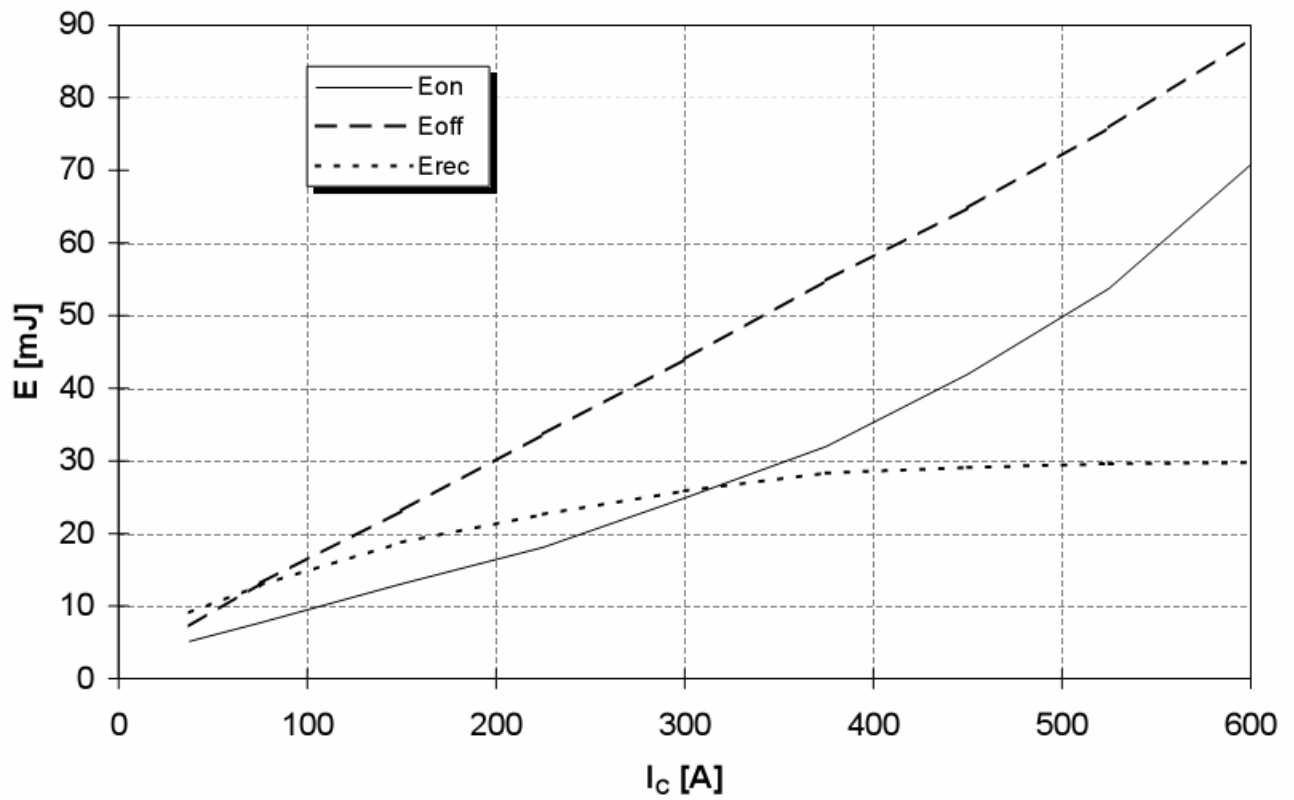


Рис. 9. Зависимость энергии потерь включения, выключения и восстановления от тока коллектора.

$$E_{on}=f(I_c), E_{of}=f(I_c), E_{rec}=f(I_c)$$

$$V_{ge}=\pm 15\text{В}, V_{ce}=600\text{В}, R_{g(on)}=2,4\ \Omega, T_j=125^\circ\text{C}$$

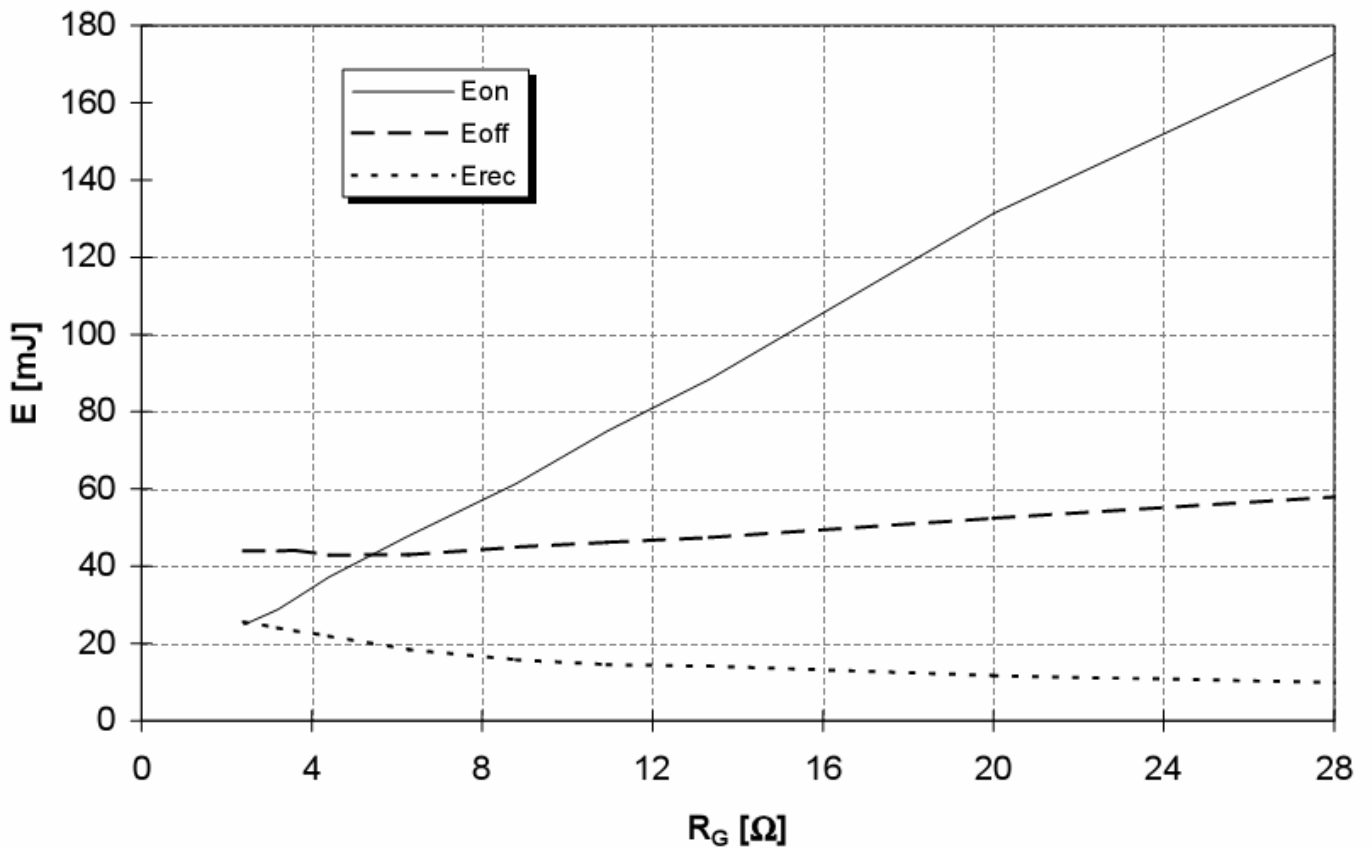


Рис. 10. Зависимость энергии потерь включения, выключения и восстановления от сопротивления затворного резистора.

$$E_{on}=f(R_g), E_{of}=f(R_g), E_{rec}=f(R_g),$$

$$V_{ge}=\pm 15\text{В}, V_{ce}=600\text{В}, I_c=300\text{А}, T_j=125^\circ\text{C}$$